# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-150439

(43) Date of publication of application: 30.05.2000

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

B08B 3/12

(21)Application number : 10-326918

(71)Applicant: EBARA CORP

(22) Date of filing:

17.11.1998

(72)Inventor: YOSHIDA MASAO

**ATO KOJI** 

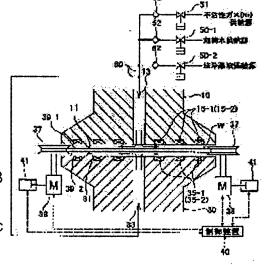
**OIKAWA FUMITOSHI** 

## (54) WASHING DEVICE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a washing device wherein washing is effectively performed with less washing liquid, no expendable part such as sponge is required, a wafer is dried clean a washing process is not extended even with a semiconductor wafer of larger diameter, and an overall size is reduced.

SOLUTION: Upper and lower members 10 and 30 facing the upper and lower surfaces of a semiconductor wafer W with specified intervals 39-1 and 39-2 are provided. The upper and lower members 10 and 30 are provided with washing-liquid supply channels 13 and 33 which supply a washing liquid required for forming a liquid film on the upper and lower surface of the semiconductor wafer W, with ultrasonic wave vibrators 15 and 35 which apply the ultrasonic wave vibration into the liquid film fitted as well. The ultrasonic wave vibration is applied in the liquid film formed on the upper and lower surfaces of the



semiconductor wafer W housed between the upper and lower members 10 and 30 so that a dust sticking to the semiconductor wafer W is washed and removed. Switching among valves 50-1, 50-2, and 51 allows an inert gas to be supplied to the wafer W, so that the wafer W is dried in a clean state.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

30.11.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2000-150439 (P2000-150439A)

(43)公顷日 平成12年5月30日(2000.5.30)

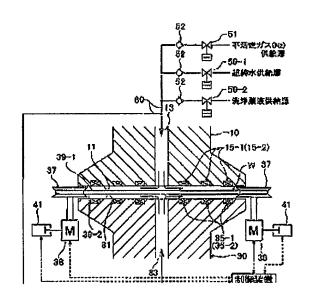
(51) Int.CL?	織別記号	FI	テーマコード(参考)
H01L 21/304	643	HOIL 21/304	643D 3B201
			6 4 3 A
	645		645A
B08B 3/12		B 0 8 B 3/12	C
		海交 水箭查离	部球 菌球項の数5 OL (全 7 頁)
(21)出職番号	<b>特膜平10−326918</b>	(71)出顧人 000	000239
		株型	<b>(会社社際製作所</b>
(22)出願日	平成10年11月17日(1998.11.17)	東京都大田区羽田旭町11番1号	
		(72) 発明者 吉日	正夫
		東方	《都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
		在風	<b>起</b>
			<b>港</b> 港司
		· ·	《都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
			要作所内
		(74)代理人 100	087066
		弁型	聖士 熊谷 隆 (外1名)
		1	

#### (54) 【発明の名称】 洗净装置

## (57)【要約】

【課題】 少ない洗浄液で効果的な洗浄が行え、スポン シ等の消耗部品が不要で、ウェハを清浄な状態で乾燥が 可能で、例え半導体ウエハが大径化しても洗浄プロセス タイムが長くならず、装置の小型化も図れる洗浄装置を 提供する。

【解決手段】 半導体ウエハWの上下面に対して所定の 隙間39-1、2を介して対向する上下部材10、30 を具備する。上下部材10、30には半導体ウエハWの 上下面に液膜を形成するに必要な洗浄液を供給する洗浄 液供給路13、33を設置し、且つ液膜中に超音液振動 を印加する超音波振動子15、35を取り付ける。上下 部村10,30間に収納した半導体ウエハWの上下面に 形成される液膜中に超音波振動を加えることで半導体ウ



最終頁に続く

特闘2000-150439

4

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄板状の接洗浄物の上下面に対して所定 の隙間を介して対向する上下部材を具備し、

1

該上下部材にはそれぞれ接洗浄物の上下面に液膜を形成するに必要な洗浄液を供給する洗浄液供給手段を設置

且つ該上下部村の両者又は何れか一方には前記液膜中に 超音液振動を印加する超音液振動子を取り付け。

前記上下部材間に収納した核洗浄物の上下面に形成される液膜中に超音液振動を加えることで核洗浄物に付着し 19 ているダストを洗浄して取り除くことを特徴とする洗浄 装置。

【語求項2】 前記被洗浄物を制御された速度で回転又は移動させる手段を設け、該手段によって被洗浄物を回転又は移動しながら洗浄を行なうことを特徴とする請求項1記載の洗浄装置。

【語求項3】 前記被洗浄物の上下面に、不活性ガスを 供給する不活性ガス供給手段を設け、該不活性ガスの流 れにより被洗浄物の上下面を乾燥させることを特徴とす る語求項1記載の洗浄装置。

【請求項4】 前記超音波振動子の種類を二種類以上とし、各種類の超音波振動子毎に異なる周波数域の超音波 振動を被洗浄物に与えることを特徴とする請求項1記載 の洗浄装置。

【語求項5】 洗浄液として複数種類の液体を具備し、 該複数種類の液体を選択して前記洗浄液供給手段に供給 する洗浄液選択手段を設けたことを特徴とする語求項1 記載の洗浄装置。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体ウェハや大型 液晶板等の被洗浄物を洗浄する洗浄装置に関するもので ある。

#### [0002]

【従来の技術】半導体ウエハ等の高泉積化が進むにつれて回路の配線が微細化し、このため半導体ウエハ等上に許容される残留ダストの数・大きさも十分小さいものでなければならなくなり、従ってこの半導体ウエハ等を効果的に洗浄する洗浄装置が必要になっている。

【0003】との種の洗浄装置としては以下に示すバッ チ式超音波洗浄装置と枚葉式洗浄装置とがある。

【0004】 [バッチ式超音波洗浄装置】この洗浄装置は、多数枚の半導体ウェハを一度に洗浄する構造のものであり、図5に示すように、大きな槽101の中に多数性の半速体のエル形を開始したカゴ102を提売し、株

6に示すように、回転駆動させている1枚の半導体ウェハWの上下面に、ノズル115から洗浄液を供給しながら、回転する円柱型ブラシ111、111を擦り付けてダストを取り除く構造のものや、図7に示すように、回転駆動させている1枚の半導体ウェハWの表面に、ノズル125から洗浄液を供給しながら、回転するペンシル型ブラシ121を取り付け、且つ該ペンシル型ブラシ121を取り付けたアーム123を矢印a方向に揺動することで半導体ウェハWの上面全体にペンシル型ブラシ121を接触させることでダストを取り除く構造のもの等がある。

【0006】また枚葉式洗浄装置の中には、図8に示すように、回転駆動させている半導体ウエハWの表面に、 洗浄液噴射用ノズル131を半導体ウエハWの略半径方 向に揺動させつつ該ノズル131から噴出した洗浄液を 吹き付け、これによって半導体ウエハW表面のダストを 取り除く構造のものもある。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記各従 20 乗例には以下のような問題点があった。

の図5に示すバッチ式超音波洗浄装置の場合、半導体ウエハWの大径化に伴い、槽101の容積が大きくなり過ぎ、これによっての洗浄液の入れ替え時間が長くなって洗浄プロセスタイムの短幅化が図れない。②洗浄液の使用量が増えてコストがかかってしまう。

【0008】またある半導体ウエハWから取り除かれた パーティクルが汚染源となって再び関り合わせた半導体 ウエハWに付着してしまう恐れがある。

【0009】 Ø図6、図7、図8に示す枚葉式洗浄装置の場合、半導体ウェハWは線又は1点で洗浄されるため、半導体ウェハWの大径化に伴い、洗浄プロセスタイムが長くなってしまう。また図6、図7に示す枚葉式洗浄装置の場合、円柱型プラシ111、111やペンシル型プラシ121を構成するスポンジの耐久寿命が半導体ウエハWの大面積化に反比例して短くなる。

【①①1①】また従来の枚葉式洗浄装置によるウエハの 乾燥は、ウエハを高速で回転させ、発生する途心力によ る水切りによって行なっている。しかしながら乾燥の 際、水分と空気中酸素の影響により、ウエハ表面にウォ 40 ーターマークが発生し、プロセス性能を悪化させる要因 となっている。

【①①11】さらにウェハ回転の手法及びウェハ保持部の形状によっては、高速回転時にウエハの周囲に気流を発生させ、装置内部に付着していたバーティクル等を巻き上げ、カェルキャに仕着させ、プロエス解析を展示さ

特闘2000-150439

さらに装置の小型化も図れる洗浄装置を提供することにある。

【0013】また本発明の他の目的は、被洗浄物乾燥時のプロセス性能の悪化条件を排除して被洗浄物を清浄な状態で乾燥できる洗浄装置を提供することにある。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた め本発明にかかる洗浄装置は、薄板状の被洗浄物の上下 面に対して所定の隙間を介して対向する上下部村を具備 し、該上下部村にはそれぞれ被洗浄物の上下面に液膜を 16 形成するに必要な洗浄液を供給する洗浄液供給手段を設 置し、且つ該上下部材の両者又は何れか一方には前記液 膜中に超音波振動を印加する超音波振動子を取り付け、 前記上下部材間に収納した核洗浄物の上下面に形成され る波膜中に超音波振動を加えることで被洗差物に付着し ているダストを洗浄して取り除くことを特徴とする。ま た本発明は、前記被洗浄物を制御された速度で回転又は 移動させる手段を設け、該手段によって被洗浄物を回転 又は移動しながら洗浄を行なりことを特徴とする。また 本発明は、前記洗浄液の流路を利用して前記被洗浄物の 上下面に不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段を設 け、該不活性ガスの流れにより被洗浄物の上下面を清浄 な状態で乾燥させることを特徴とする。また本発明は、 前記超音波振動子の種類を二種類以上とし、各種類の超 音波振動子毎に異なる周波数域の超音波振動を披洗浄物 に与えることを特徴とする。また本発明は、洗浄液とし て、複数種類の液体を具備し、該複数種類の液体を選択 して前記洗浄液供給手段に供給する洗浄液選択手段を設 けたことを特徴とする。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の一実施形態にかかる枚葉式の超音波洗浄装置の機略側断面図である。同図に示すようにこの洗浄装置は、上部材10と下部材30とを具備して構成されている。上部材10と下部材30の間には、ウェハWの外周を均等な位置で保持し且つ回転させるためのウェハ回転保持部村37を4個90で間隔で設けている(図1ではウェハWの1つの直径方向に位置させた2つのウエハ回転保持部材37、37のみ図示している)。なおウエハ回転保持部材37は3個40又はそれ以上でも構わない。また上部村10と下部材30は、図示しない昇降手段により昇降可能に構成されている。

【0016】各ウエハ回転保持部材37は駆動手段(サールス・ク)28の同志機力により関連体票40の制御

れによってウエハWの保持・関放を行なう。

【0017】図2は上部村10の下面11(又は下部村30の上面31)を示す図である。同図及び図1に示すように上部村10は、その下面11が平面状であって、その外形寸法が半導体ウエハWの外形寸法よりも若干大きく形成されている。またこの上部村10の中央には洗浄液供給路13が設けられている。また図1及び図2に示すように、上部村10の下面11には超音波振動子群15-1と超音波振動子群15-2とがそれぞれ直径方向に1列に所定の間隔で中央で交差するように埋め込まれその表面が下面11上に露出している。

【0018】次に下部材30は、その上面31が平面状であって、その外形寸法が前記上部材10の下面11と 略同一外形寸法に形成されている。またこの下部材30 にも上部材10と同様に、その中央に洗浄液供給路33 が設けられ、また上部材10と同様に、図1及び図2に示すようにその上面31に超音波振動子群35-1と超音波振動子群35-2とが1列となって中央で交差するように退め込まれその表面が上面31上に露出している。

【0019】超音波振動子群15-1、35-1は200~500kH2程度の周波数で振動可能で、超音波振動子群15-2、35-2は1000~1200kH2程度の周波数で振動可能となっており、ウェハWの膜程、配線ルール、配線パターンにより選択又は切り換えが可能に構成されている。

【0020】そして図1に示すようにこの真施形態にお いては、ウエハWの外周を4個のローラ型のウエハ回転 保持部材37で保持することで、ウエハWと上下部材1 30 (0,30との間に所定寸法の隙間39-1,39-2を 確保している。なお回転するウエハ♥の全面に均一に超 音波振動が行き渡る様にするため、超音波振動子群15 -1.15-2.35-1.35-2の発生させる超音 波の周波数と振幅を考慮し、ウエハ♥との距離を最適距 離に保てる様、必要に応じ下面11及び上面31の所定 部分に起伏又は凹凸を設け、その起伏又は凹凸の部分に それぞれ超音波振動子群15-1,15-2,35-1. 35-2を設置しても良い。即ち要は図9に示すよ ろに、下面11 (又は上面31)に取り付ける超音波振 助子の、②の超音波の周波数や振幅が異なる場合に、そ れぞれウエハWとの距離し1, し2を最適距離(最適な 洗浄効果を得る距離)に保てる様に下面11(又は上面 31) に起伏又は凹凸を設けてその起伏又は凹凸の部分 にそれぞれ超音波振動子群®、<br />
のを設置するものであれ

5

されている。各供給源の下流側の配管には、それぞれバルブ50-2、50-1、51と、逆止弁52とが取り付けられている。これらバルブ50-2、50-1、51は制御装置40によって駆動されるように構成されており(図では図示の都台上、両者を結ぶ線の記載は省略している)、何れかのバルブ50-2、50-1、51を開くことで、洗浄薬液又は超純水又は不活性ガスが洗浄液供給路13、33に供給される。ここで洗浄薬液供給源と超純水供給源とこれらのバルブ50-2、50-1及び逆止弁52とが洗浄液送択手段を構成し、また不活性ガス供給源とそのバルブ51と逆止弁52とが不活性ガス供給源とそのバルブ51と逆止弁52とが不活性ガス供給源とそのバルブ51と逆止弁52とが不活性ガス供給源とそのバルブ51と逆止弁52とが不活性ガス供給源とそのバルブ51と逆止弁52とが不活性ガス供給源とでのバルブ50-2。

【10022】次にこの洗浄装置の動作を説明する。ポリッシング装置等によってその表面研磨などの処理の終わった半導体ウエハWは図示しないロボットハンドなどによって洗浄装置内に鍛送され、駆動手段41によって外方に移動していた各ウエハ回転保持部村37を駆動手段41を駆動することで内側に移動してウエハWの外周を保持せしめ、ロボットハンドから受け渡しを行なう。ロボットハンドを待機位置に戻す。

【0023】次に下部材30と上部村10とをウエハWに所定の隙間39-1,39-2をあけて接近させる。【0024】次にバルブ50-1やバルブ50-2を開くことで両洗浄液供給路13,33から洗浄液(超純水や蒸液など)を各ヶ所定量供給することで、隙間39-1及び隙間39-2にそれぞれ液膜を形成する。上下の洗浄液の流置は、少なくとも洗浄液の流れによる表面張力によって半導体ウエハWの上下全面に常に液膿が保てる程度の厚みとなるように調整されている。

【0025】なお図では省略したが、上部材10及び/ 又は下部材30の各々の外周近傍にはウエハ回転保持部 材37の箇所を除いて各々下方及び/又は上方に延びる 上記兼順の過度な流出を防ぐための堰を設けている。

【① 026】そしてこの状態で前記両超音波振動子15 -1、35-1を駆動して液膜となっている洗浄液に超音波振動を加え、ウエハWの洗浄を開始する。

【0027】ウエハWの洗浄関始に合わせ、各駆動手段 38を回転駆動することによりウエハWを所定の速度で 回転させる。これによりウエハ全面に超音波が印加され た洗浄液が供給される。

【0028】所定の時間、超音波振動子15-1、35-1を使用した洗浄を行なった後に、必要に応じ、超音波振動子15-2、35-2への切り換えを行なう場合もある。この際、ウエハWの回転速度や隙間39-1、20、2の世代の洗浄なが更して社会を行なるとした可能

【0030】とれによって半導体ウエハWの上下面に付着しているダストは、前記洗浄液の流れ及び該洗浄液に加えられる超音液振動によって効果的に取り除かれ、外部に排出される。

【0031】本流浄装置にウェハWの乾燥を行なわせる必要がある場合は、バルブ50-1、50-2を閉じ、バルブ51を開くように切り換えることにより、ウェハWの上下面にN。等の不活性ガスを供給する。

給源と超純水供給源とこれらのバルブ50-2、50- 【0032】ウエハWの乾燥をより効率的に行なうため 1及び逆止弁52とが洗浄液選択手段を構成し、また不 10 に、例えば不活性ガスが80℃以上の高温になるように 活性ガス供給源とそのバルブ51と逆止弁52とが不活 加温を行なったり、ウエハWの回転速度が1000 rp 性ガス供給手段を構成している。 加以上の高速回転速度となるように乾燥プロセス条件を 【0022】次にこの洗浄装置の動作を説明する。ポリ 制御することもある。

> 【 0 0 3 3 】以上本発明の一実施形態を説明したが、本 発明は上記実施形態に限定されるものではなく。例えば 以下のような種々の変形が可能である。

【0034】の図3に示すように、上部材10に復液供 船路21を設け、一度排出した洗浄液からダストを取り 除いた復液又は別の処理工程で使用した後の復渡を供給 20 するように構成しても良い。ボリッシング装置等によっ て研磨した直後の半導体ウエハ型は汚染の程度が高く、 洗浄液として例えば純水を用いる必要はないので、例え ば洗浄開始時は一度処理に用いた復液を用い、半導体ウ エハ型の汚染度が低くなった段階で洗浄液供給路13か も超純水を供給するように切り換えても良い。

【りり35】また復液供給路21を設けず、洗浄液供給路13,33によって当初復液を供給し、次に純水を供給するように切り換えても良い。また純水と復液の使い分けは他にも種々の方法が考えられる。

5 【0036】また上記実施形態では洗浄液として超極水と洗浄菜液を使用したが、洗浄液はこれらのものに限定されない。即ち洗浄液は、超純水、イオン水、オゾン水、酸性菜液、塩基性菜液、有機溶材、水素水等であればよく、これら複数種類の液体を選択して洗浄液供給路13、33に供給するように構成すれば良い。

【0037】の図3に示すように、下部材30に排液路41を設け、該排液路41から排液するように構成しても良い。このように構成すれば、中央の洗浄液供給路13、33から供給された洗浄液が外周に至る前にその一40 部を排液できる。半導体ウエハ型の中央のみが特に汚染されているような場合は効果的である。

【0038】**③上記**実施形態では洗浄液供給手段として上下部材10、30の中央にそれぞれ設けた洗浄液供給 路13、33に洗浄液を供給するように構成したが、他の手間によって上下部材10、2000間に洗浄液を供給 (5)

8

せる例を挙げたが、例えば図4に示すように、回転円板90にウェハWの外周側面を保持する爪91を設け、回転円板90の回転軸92を中空軸としてなる中空軸サーボモータ(駆動手段)95の該中空軸内に下部村30を貫通して管路33を形成する構造とする例も考えられる。なお配管60やバルブ50-1、2,51等の記載はこの図では省略している。また図では省略するが、爪91は開閉可能に構成されており、ウエハWの把持・離脱が行なえるように構成されている。

【0040】なお、回転中心はウェハWの中心位置に限 10 効果が得られる。 らず、中心位置からずらし、偏心した回転運動を行なっ 【0049】 ② 2 たり、スクロール運動や、直線的な水平移動を繰り返す ンテナンスも容易 方法等、プロセス中のウエハWの回転・移動の方法は、 【0050】 ③ 5 ウエハWの設置平面内を移動するものであれば特に限定 タイムが長くなる はされない。 【0051】 ⑤ 8

【0041】の上記実施形態では上下部材10、30の両者に超音波振動子15-1、15-2、35-1、35-2を取り付けたが、半導体ウエハWの上下面の何れか一方の面を主として洗浄するような場合は、上下部材10、30の何れか一方のみに超音波振動子を取り付けても良い。

【① 042】 ⑥上記実施形態では被洗浄物として半導体 ウエハを用いたが、液晶板などの他の各種被洗浄物にも 適用できることは言うまでもない。

【0043】の上記実施形態ではウエハWを接触保持するウエハWの回転保持手段(37,91)を用いたが、ベルヌーイ効果を利用したウエハWの回転保持手段を用いても良い。

【0044】®洗浄液供給路13,33に洗浄液の温度 制御装置を設け、洗浄液の温度を所定の温度にコントロ 30 ールしても良い。或いは上下部材10,30の表面(下面11と上面31)近傍にヒータを埋め込み、洗浄液の 温度をコントロールしても良い。

【① 0.4.5】 切また上下部村10,30に複数の洗浄液 供給路を設けて、各々の供給路から供給する洗浄液の供 給流量を制御するようにしても良い。

【①①46】また上記実施例では超音波振動子15(15-1,2)、35(35-1,2)は直接洗浄液に触れるように構成したが、上下部材10、30の表面(下面11と上面31)に他の超音波振動板を設け、この板 40に超音波振動子15,35を取り付けて超音波振動子15、35の振動を板に伝えるようにしても良い。さらに板の材質を耐薬液材にすれば、洗浄液として菜液を使う場合。板の腐食を防け、また超音波振動子15、35は海洋水流に触れるいので、約3沖に成了15、35は海洋水流に触れるいので、約3沖に成了15、35は海洋水流に触れるいので、約3沖に成了15、35は

[0.047]

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれ ば以下のような優れた効果を有する。

①被洗浄物の上下面に液膜を形成する程度の洗浄液を供給するだけで洗浄できるので、使用する洗浄液の量が少なくてすむ。

【りり48】 ②核洗浄物の上下面に付着しているダストは、常に新しい洗浄液の供給及び該洗浄液に加えられる 超音波振動によって効果的に取り除かれるので高い洗浄 効果が得られる。

【① 0 4 9 】 ②スポンジ等の消耗部品が不要であり、メンテナンスも容易である。

【① 05 0】 **②**たとえ被洗浄物が大径化してもプロセス タイムが長くなることはない。

【0051】 **⑤**清浄な不活性ガスを用いて被洗浄物を乾燥させるため、被洗浄物を清浄に乾燥できる。

【0052】 

⑥洗浄液中に核洗浄物を浸漬した状態で該 洗浄液に超音波振動を加える構造であるにもかかわら ず、図5に示すような従来の浸漬型の洗浄装置に比べて その大きさを大幅に小型化できる。また被洗浄物を清浄 に乾燥できる。従って浸渍型の洗浄機であるにもかかわ らず容易にポリッシング装置室内等に設置するととがで きる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかる枚葉式の超音波洗 浄装置の概略側断面図である。

【図2】上部村10の下面11(又は下部村30の上面31)を示す図である。

【図3】他の実施形態にかかる枚葉式の超音波洗浄装置の概略側断面図である。

【図4】他の実施形態にかかる枚葉式の超音波洗浄装置の概略側断面図である。

【図5】従来のバッチ式超音波洗浄装置の一例を示す図である。

【図6】従来の枚葉式洗浄装置の一例を示す図である。

【図?】従来の枚葉式洗浄装置の一例を示す図である。

【図8】従来の枚葉式洗浄装置の一例を示す図である。

【図9】超音波振動子の、②の取り付け状態を示す要部 概略断面図である。

#### 46 【符号の説明】

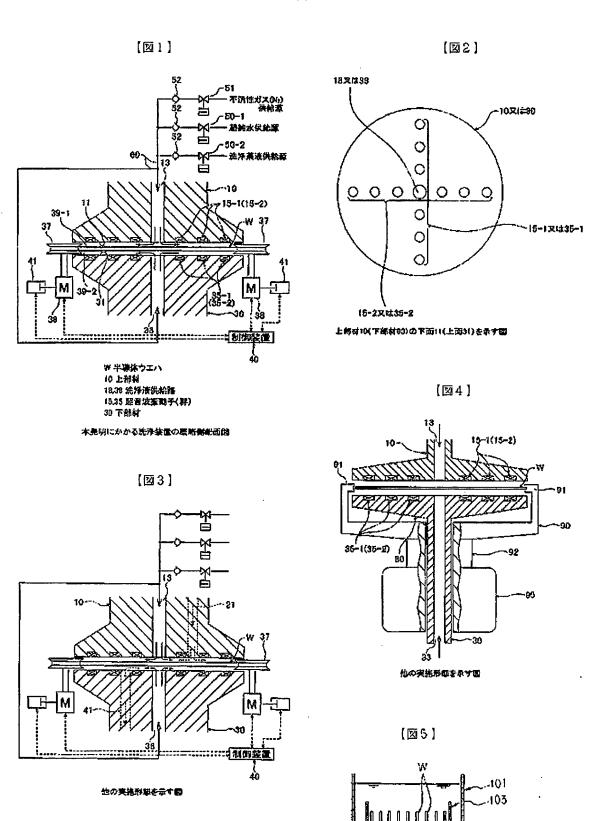
₩ 半導体ウエハ (被洗浄物)

10 上部材

13 洗净液供給路(洗净液供給手段)

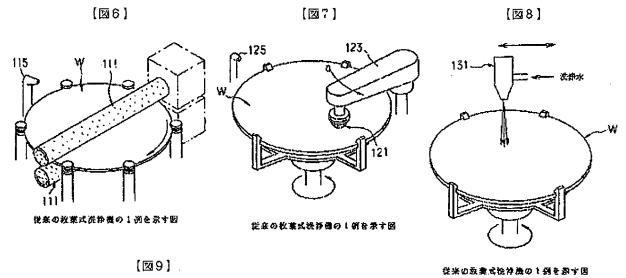
15-1, 2 超音波振動子(群)

2 12 Tall+



(7)

特開2000-150439



11(31)

疫苗技術を子の取付状態を示す図

フロントページの続き

(72) 発明者 及川 文利 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所內 F ターム(参考) 38201 AA03 A824 A834 A844 BA13 BA15 B802 B822 B845 B862 B832 B835 B892 B893 B895 B896 C812 CC12 CC13

JP 2000-150439 A5 2005.7.21

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【公開番号】特開2000-150439(P2000-150439A)

【公開日】 平成 12年5月30日 (2000.5.30)

【出願番号】特願平10-326918

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/304

3/12 B 0 8 B

[F I]

H 0 1 L 21/304 643D

HOIL 21/304 643A

H 0 1 L 21/304 6 4 5 A

B 0 8 B 3/12 C

## 【手続補正書】

【提出日】平成16年11月30日(2004,11.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細音

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】洗浄装置及び洗浄方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被洗浄物の上下面に対して所定の隙間を介して対向する上下部材を具備し、

該上下部材にはそれぞれ被洗浄物の上下面に液膜を形成する洗浄液を供給する洗浄液供 給手段を設置し、

且つ該上下部材の両者又は何れか一方には前記液膜中に超音波振動を印加する超音波振 動子を取り付け、

前記上下部材間に収納した被洗浄物の上下面の両者又は何れか一方に形成される液膜中 に超音波振動を加えることで被洗浄物に付着しているダストを洗浄して取り除くことを特 徴とする洗浄装置。

### 【請求項2】

前記被洗浄物を制御された速度で回転又は移動させる手段を設け、該手段によって被洗 浄物を回転又は移動しながら洗浄を行なうことを特徴とする請求項1記載の洗浄装置。

## 【請求項3】

前記被洗浄物の上下面に、不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段を設け、該不活性

洗浄液として複数種類の液体を具備し、該複数種類の液体を選択して前記洗浄液供給手段に供給する洗浄液選択手段を設けたことを特徴とする請求項1記載の洗浄装置。

### 【請求項6】

ئي ب الي

被洗浄物の上下面に対して所定の隙間を介して上下部材を対向し、

前記上下部材に設置した洗浄液供給手段からそれぞれ被洗浄物の上下面に洗浄液を供給して液膜を形成し、

<u>同時に前記上下部材の両者又は何れか一方に取り付けた超音液振動子から前記液膜中に</u> 超音波振動を印加することによって、

前記上下部材間に収納した被洗浄物の上下面の両者又は何れか一方に形成される液膜中 に超音波振動を加えることで被洗浄物に付着しているダストを洗浄して取り除くことを特 徴とする洗浄方法。

【手続補正3】

[補正対象書類名] 明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は半導体ウエハや大型液晶板等の被洗浄物を洗浄する洗浄装置<u>及び洗浄方法</u>に関するものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0012]

本発明は上述の点に鑑みてなされたものでありその目的は、少ない洗浄液で効果的な洗 冷が行え、スポンジ等の消耗部品が不要であり、また例え半導体ウエハが大径化しても洗 浄プロセスタイムが長くならず、さらに装置の小型化も図れる洗浄装置<u>及び洗浄方法</u>を提 供することにある。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0014]

【課題を解決するための手段】

上記問題点を解決するため本発明にかかる洗浄装置は、被洗浄物の上下面に対して所定の隙間を介して対向する上下部材を具備し、該上下部材にはそれぞれ被洗浄物の上下面に液膜を形成する洗浄液を供給する洗浄液供給手段を設置し、且つ該上下部材の両者又は何れか一方には前記液膜中に超音液振動を印加する超音液振動子を取り付け、前記上下部材間に収納した被洗浄物の上下面の両者又は何れか一方に形成される液膜中に超音液振動を加えることで被洗浄物に付着しているダストを洗浄して取り除くことを特徴とする。

また本発明は、前記被洗浄物を制御された速度で回転又は移動させる手段を設け、該手段によって被洗浄物を回転又は移動しながら洗浄を行なうことを特徴とする。

また本発明は、洗浄液として、複数種類の液体を具備し、該複数種類の液体を選択して 前記洗浄液供給手段に供給する洗浄液選択手段を設けたことを特徴とする。

また本祭明にかかる洗浄方法は、被洗浄物の上下面に対して所定の隙間を介して上下部材を対向し、前記上下部材に設置した洗浄液供給手段からそれぞれ被洗浄物の上下面に洗浄液を供給して液膜を形成し、同時に前記上下部材の両者又は何れか一方に取り付けた組音液振動子から前記液膜中に超音液振動を印加することによって、前記上下部材間に収納した被洗浄物の上下面の両者又は何れか一方に形成される液膜中に超音波振動を加えることで被洗浄物に付着しているダストを洗浄して取り除くことを特徴とする。